06:11:12

Фотоэлектронная эмиссия из гранулированных пленок золота, активированных цезием и кислородом

© Э.Л. Нолле, М.Я. Щелев

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 119991 Москва, Россия e-mail: nolle@ran.gpi.ru

(Поступило в Редакцию 14 марта 2005 г.)

Обнаружено, что в гранулированных пленках золота, активированных цезием и кислородом, в видимой области спектра возникает интенсивная полоса фотоэлектронной эмиссии шириной примерно 100 nm с чувствительностью около 4 mA/W при длине волны 530 nm, которая, по-видимому, обусловлена возбуждением поверхностных плазмонов. Из исследований следует, что вследствие поверхностного фотоэффекта пленки золота активированные Сs и О можно использовать в качестве быстродействующих фотокатодов с постоянной времени несколько фемтосекунд.

Известно, что при поглощении и отражении света тонкими гранулированными металлическими пленками в видимой области спектра из-за размерных эффектов возникают полосы поглощения, которые у массивных металлов отсутствуют [1]. В [2] показано, что в гранулированных пленках, состоящих из наночастиц Аи, наблюдается полоса поглощения вблизи 600 nm, а в пленках из наночастиц Ад полоса поглощения находится вблизи 500 nm [3]. Согласно [2,3], возникновение этих полос поглощения вызвано возбуждением поверхностных плазмонов в металлических наночастицах, представляющих собой сплюснутые сфероиды. При этом отношение заполненной наночастицами площади подложки к общей составляло для Au $f \approx 10^{-3}$ [2], а для Ag $f \approx 0.5$ [3], что свидетельствовало о вертикальном росте наночастиц Аи на поверхности подложки, средний размер которых был $z \approx 3-4$ nm. В [4] нами обнаружена интенсивная фотоэлектронная эмиссия (ФЭ) в спектральной области 500 nm из наночастиц Ag, активированных Cs и О, которая, по-видимому, обусловлена возбуждением поверхностных плазмонов в таких сфероидах. Так как в этом случае отсутствует транспорт фотоэлектронов к поверхности, для фотокатодов на основе металлических наночастиц можно ожидать малой, порядка фемтосекунд, постоянной времени, определяемой временем прохождения плазмона через наночастицу. В настоящее время в связи с развитием нового направления в науке и технике — фемтосекундной фотоэлектроники [5] проблема создания таких фотокатодов стала актуальной. Кроме того, для получения фемтосекундных импульсов электронов с помощью возбуждения мощными импульсными лазерами, наиболее удобны металлические фотокатоды, так как они обладают высокими значениями теплопроводности, электропроводности и теплоемкости. К ним относятся массивные фотокатоды с неактивированной поверхностью, работающие в режиме "на отражение" при скользящем падении луча света к поверхности, основанные на использовании поверхностного фотоэффекта при однофотонном [6] и многофотонном [7,8]

возбуждениях. Однако чувствительность таких фотокатодов мала и составляет для сплошных пленок Au примерно $3\,\mu\text{A/W}$ при $\lambda=250\,\text{nm}$ [6] и $10^{-2}\,\mu\text{A/W}$ при $\lambda=800\,\text{nm}$ [7].

Целью работы явилось получение в гранулированных пленках Au ФЭ в видимой области спектра, обусловленной поверхностными плазмонами, и сравнение ее со свойствами, известными для массивных образцов Au, а также с ранее полученной нами ФЭ из наночастиц Ag [4].

Изготовление гранулированных пленок Аu, их активировка Cs и O, измерения спектров ФЭ и отражения света, а также определение состава их поверхности с помощью оже-AES и рентгеновской XPES электронных спектроскопий проводились при вакууме 10^{-10} Torr по такой же методике, как и для пленок Ag [4]. На тонкую, толщиной $d \approx 3$ nm, пленку Al_2O_3 , образованную на толстой ($d \approx 100\,\mathrm{nm}$) пленке Al, напылялась пленка Au толщиной $d=7\,\mathrm{nm}$, которая затем прогревалась при $T \approx 300^{\circ} \text{C}$ в течение 20 min. При таких условиях обычно образуются гранулированные пленки, о чем свидетельствуют исследования XPES, в спектрах которых наблюдались пики Al_{2p} и Al_{2s} от подложки, примерно равные по интенсивности пику Au_{4f} от наночастиц Au . Так как коэффициенты элементной чувствительности для соответствующих пиков А1 примерно в 10 раз меньше, чем для Au, то величина $f \approx 0.1$, что указывало на вертикальный рост наночастиц. Пленки Аи активировались Cs и O при постоянно включенном источнике Cs. В отличие от пленок Ад источник О, который повышал давление в камере примерно на порядок, включался только на последней стадии активировки после падения чувствительности Ѕ приблизительно на 30% от максимума при активировки одним Cs (в момент времени 2 на рис. 1). Это приводило к увеличению величины Sпримерно на один-два порядка как для гранулированных, так и для сплошных пленок Аи. При этом для получения максимальной чувствительности в красной области спектра активировка вначале проводилась при

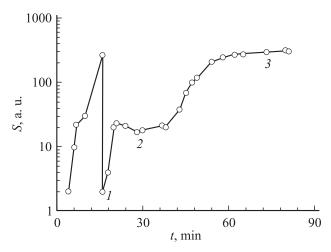


Рис. 1. Зависимость чувствительности S гранулированных пленок Au от времени t при активировки Cs и О. Источник Cs включен постоянно; моменты времени: I — введен светофильтр КС-19, 2 — включен источник кислорода, 3 — выключен источник кислорода.

освещении белым светом, а затем при освещении через красный светофильтр КС-19, пропускающий свет только с $\lambda \geq 700\,\mathrm{nm}$ (момент времени I на рис. 1). ФЭ возбуждалась неполяризованным светом под углом 0, а отражения света измерялось под углом 45° к нормали поверхности пленок.

Спектральная чувствительность $S(\lambda)$ сплошных пленок $(d=50\,\mathrm{nm})$, активированных Сs и O в исследованном диапазоне $\lambda=400-800\,\mathrm{nm}$ (кривая 2 на рис. 2), была примерно в 10 раз больше, чем для пленок, активированных одним Cs (кривая I). Спектр $S(\lambda)$ этих пленок представлял одну широкую полосу с максимумом при $\lambda_1=430\,\mathrm{nm}$, равным $S_m=1.8\,\mathrm{mA/W}$, что соответствует квантовому выходу по отношению к падающим фотонам Q=0.52%. Как видно из рис. 2, спектральное положение этой полосы Φ 3 (кривая 2) совпадает со спектральным положением полосы отражения света $R(\lambda)$, минимум которого достигается при $\lambda \leq 500\,\mathrm{nm}$ и составляет R=40% (кривая 4 на рис. 2). Эта полоса отражения, согласно [9], вызвана межзонным поглощением света в объеме 20.

В спектрах $S(\lambda)$ гранулированных пленок, активированных Сs и O, возникала новая длинноволновая полоса Φ Э (кривая 3 на рис. 2) шириной примерно 100 nm с максимумом при $\lambda_2=530$ nm, чувствительность в котором составляла $S_m=3.9$ mA/W, соответствуя Q=0.9%. Интенсивность Φ Э коротковолновой полосы в этих пленках по сравнению со сплошными увеличивалась до значения $S_m=4.3$ mA/W (Q=1.24%), а край полосы отражения смещался в длинноволновую сторону с 570 до 750 nm и ее минимум уменьшался, составляя R=26% при $\lambda=480$ nm (кривая 5 на рис. 2).

Возникновение в активированных Сs и O гранулированных пленках Au новой интенсивной полосы Φ Э с максимумом при $\lambda_2=530$ nm, спектральное положение

которой (кривая 3 на рис. 2) совпадает со спектральным положением полосы отражения (кривая 5 на рис. 2), позволяет, по-видимому, объяснить эту полосу ФЭ, так же как и в аналогичных пленках Ад [4], возбуждением поверхностных плазмонов в наночастицах Аи. В отличие от пленок Ag, в спектрах поглощения которых наблюдается объемный плазменный резонанс при $\lambda = 330 \, \text{nm}$, в пленках Аи такой резонанс не наблюдается из-за сильного межзонного поглощения, начинающегося при $\lambda \le 550 \, \text{nm}$ [9]. Поэтому в спектрах отражения гранулированных пленок Аи из-за влияния полосы, обусловленной межзонным поглощением, не удается, как в случае Ад [4], четко выявить полосу, вызванную возбуждением поверхностных плазмонов. Другим отличием от пленок Ад является значительное возрастание $\Phi \Im$ до величины $S=1.8\,\mathrm{mA/W}$ в видимой области спектра из сплошных пленок Au, активированных Cs и О, тогда как при активировке одним Сѕ величина $S = 0.19 \,\text{mA/W}$ (кривые 2 и 1 на рис. 2). Так как $\Phi \ni$ в этих пленках обусловлена межзонными переходами, то из-за более низкого значения работы выхода при активировке Cs и O, чем при активировке одним Cs, большее число фотоэлектронов достигает поверхности и выходит в вакуум прежде, чем их энергия из-за рассеяния окажется ниже уровня вакуума. Различие в процессе активировки цезием и кислородом пленок Au и Ад связано, по-видимому, с различием их химических свойств: Ад активно по отношению к О, образуя окись Ад₂О, и мало активно по отношению к Сs, тогда как Au образует соединение CsAu, а по отношению к О мало активно.

Исследования методами AES и XPES показали, что физико-химический состав активированной Cs и O поверхности пленок Au и такой же, как и у пленок Ag [4].

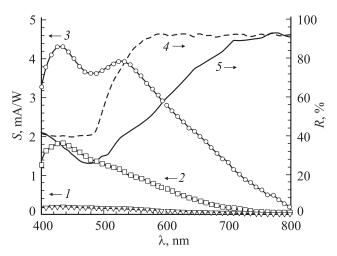


Рис. 2. Спектры чувствительности S пленок Au: I — сплошная пленка, активированная одним CS; 2 — сплошная пленка, активированная Cs и O; 3 — гранулированная пленка, активированная Cs и O. Спектры коэффициента отражения R пленок Au: 4 — сплошная пленка, 5 — гранулированная пленка.

Поэтому снижение работы выхода в пленках Au обусловлено, так же как и в пленках Ag, тонким дипольным слоем толщиной около 1 nm, состоящим из диполей ионов Cs^+ и Cs-O-Cs.

Из проведенных исследований следует, что в гранулированных пленках Аи возникает новая интенсивная полоса ФЭ, обусловленная возбуждением поверхностных плазмонов. В максимуме этой полосы при $\lambda_2 = 530\,\mathrm{nm}$ величина $S \approx 4 \, \text{mA/W}$, что на несколько порядков превышает чувствительность фотокатодов на основе неактивированных сплошных металлических пленок [6,7]. Так как при этом отсутствует транспорт фотоэлектронов к поверхности, гранулированные пленки Аи наряду с пленками Ag, активированные Cs и O, могут использоваться в качестве фотокатодов для временного анализа быстропротекающих процессов и получения электронных импульсов с разрешением несколько фемтосекунд. При этом из-за малых размеров гарнул z и величин f(вертикального роста наночастиц Au) полупрозрачные и низкоомные пленки Аи, изготовленные на прозрачной подложке, например на пленке SnO2, нанесенной на кварц, могут оказаться наиболее эффективными металлическими фотокатодами, работающими в режиме на просвет в видимой области спектра.

Работа поддержана президиумом РАН по программе научных исследований "Низкоразмерные квантовые наноструктуры" (грант N 4.12).

Список литературы

- [1] Петров Ю.И. Физика малых частиц. М.: Наука, 1982. 360 с.
- [2] Granqvist C.G., Hunderi O. // Phys. Rev. B. 1977. Vol. 16. N 8. P. 3513–3534.
- [3] Kennerly S.W., Little J.W., Warmack R.J. et al. // Phys. Rev. B. 1984. Vol. 29. N 6. P. 2926–2929.
- [4] Нолле Э.Л., Щелев М.Я. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. Вып. 8. С. 1–6.
- [5] Щелев М.Я. // УФН. 2000. Т. 170. № 9. С. 1002–1007.
- [6] Moustaizis S.D., Tatarakis M., Kalpouros C. et al. // Appl. Phys. Lett. 1992. Vol. 60. N 16. P. 1939–1941.
- [7] Bastiani-Ceccotti S., Monchicourt P., Lehner T. // Phys. Rev. B. 2003. Vol. 68. P. 1–12.
- [8] Shalaev V.M., Douketis C., Haslett T. et al. // Phys. Rev. B. Vol. 53. N 16. P. 11 193–11 206.
- [9] Johnson P.B., Christy R.W. // Phys. Rev. B. 1972. Vol. 6. N 12. P. 4370–4379.